

トランジスタ

2SD886, 2SD886A

2SD886, 2SD886A

シリコン NPN 三重拡散プレーナ形 / Si NPN Triple Diffused Planar

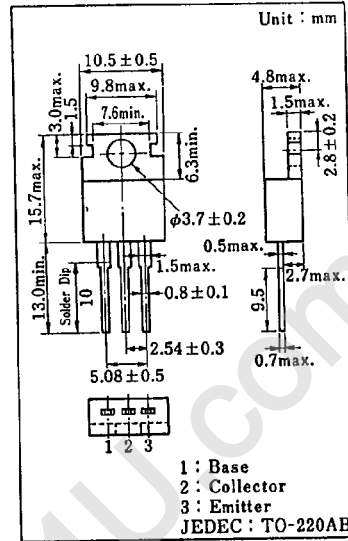
高電流増幅率, 低周波電力増幅用 / High h_{FE} , AF Power Amplifier

■ 特徴 / Features

- 直流電流増幅率 h_{FE} が高い。 / High h_{FE}
- h_{FE} の直線性がよい。 / Good linearity of h_{FE}

■ 絶対最大定格 / Absolute Maximum Ratings (Ta = 25 °C)

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	80	V
2SD886A		100	
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	60	V
2SD886A		80	
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	6	V
せん頭コレクタ電流	I_{CP}	6	A
コレクタ電流	I_C	3	A
ベース電流	I_B	1	A
コレクタ損失 (Tc = 25 °C)	P_C	40	W
接合部温度	T_J	150	°C
保存温度	T_{stg}	-55 ~ +150	°C



■ 電気的特性 / Electrical Characteristics (Ta = 25 °C)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタ シャ断電流	2SD886	$V_{CB} = 80 V, I_E = 0$			100	μA
	2SD886A	$V_{CB} = 100 V, I_E = 0$			100	
コレクタシャ断電流	I_{CEO}	$V_{CE} = 40 V, I_B = 0$			100	μA
エミッタシャ断電流	I_{EBO}	$V_{EB} = 6 V, I_C = 0$			100	μA
コレクタ・ エミッタ電圧	2SD886	$I_C = 25 mA, I_B = 0$	60			V
	2SD886A		80			
直流電流増幅率	h_{FE}^*	$V_{CE} = 4 V, I_C = 0.5 A$	500		1500	
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = 2 A, I_B = 0.05 A$			1	V
トランジション周波数	f_T	$V_{CE} = 12 V, I_C = 0.2 A$		50		MHz

* h_{FE} ランク分類 / h_{FE} Classifications

Class	Q	P
h_{FE}	500 ~ 1000	800 ~ 1500

T-33-11

